

| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">SI4102DY-T1-GE3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI4102DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4102DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12105 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI4102DY-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 12105 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 100V 3.8A (Tc) 2.4W (Ta), 4.8W (Tc) |
| Serie | TrenchFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Verlustleistung (max) | 2.4W (Ta), 4.8W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3.8A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 158 mOhm @ 2.7A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 11nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 370pF @ 50V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | SI4102DY-T1-GE3TR |

SI4102DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4102DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4102DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4102DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>SI4104DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p> |  <p>SI4104DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.6A 8-SOIC</p> |  <p>SI4103DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V SO-8</p> |  <p>SI4102DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p> |
|  <p>SI4102DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p> |  <p>SI4102DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.8A 8-SOIC</p> |  <p>SI4101DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 25.7A 8SOIC</p> |  <p>SI4101DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 25.7A 8SOIC</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  SI4010DY |  SI4010DY-T1-GE3 |  SI4010DY-T1-GE3 |  SI4012-C1001GTR |  SI4021-A1-FTR |
|  SI4022-A0-FTR |  SI4022-A1-FTR |  SI4030-A0-FM |  SI4032-V2-FMR |  SI4033-B2-FM |
|  SI4048DY-T1-E3 |  SI4056DY |  SI4056DY-T1-E3 |  SI4056SPG |  SI4058DY |
|  SI4090DY |  SI4100BDDY-T1-GE3 |  SI4100DY |  SI4100DY-T1-E3 |  SI4100DY-T1-E3 |
|  SI4100DY-T1-GE3 |  SI4100DY-T1-GE3 |  SI4102DY |  SI4102DY-T1-E3 |  SI4102DY-T1-E3 |
|  SI4102DY-T1-GE3 |  SI4104DY-T1-GE3 |  SI4104DY-T1-GE3 |  SI4108DY-T1-GE3 |  SI4108DY-T1-GE3 |
|  SI4110DY-T1-GE3 |  SI4110DY-T1-GE3 |  SI4112-D-GM |  SI4113-BMR |  SI4114DY |
|  SI4114DY-T1-E3 |  SI4114DY-T1-E3 |  SI4114DY-T1-GE3 |  SI4114DY-T1-GE3 |  SI4116DY |
|  SI4116DY-T1-E3 |  SI4116DY-T1-E3 |  SI4116DY-T1-GE3 |  SI4116DY-T1-GE3 |  SI4122-BTR |
|  SI4122-D-GMR |  SI4122DY-T1-E3 |  SI4122G-BMR |  SI4123-BM |  SI4124DY-T1-E3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited